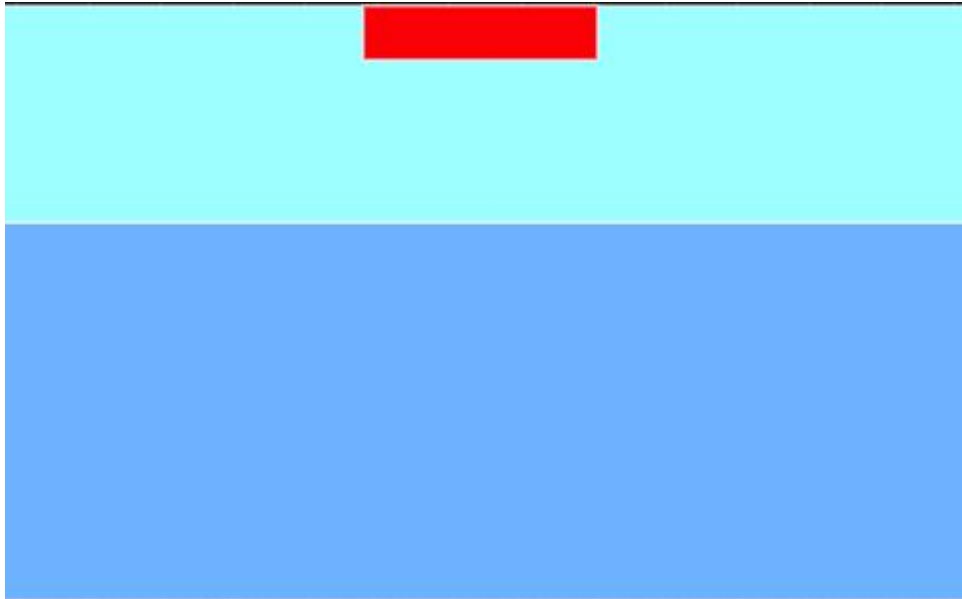


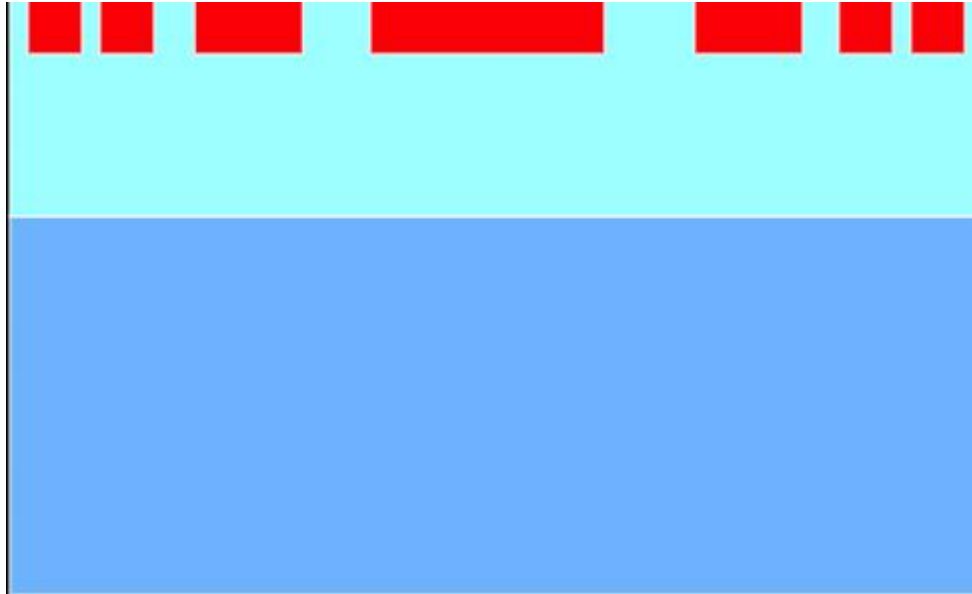
1.保护环终端的器件流程图



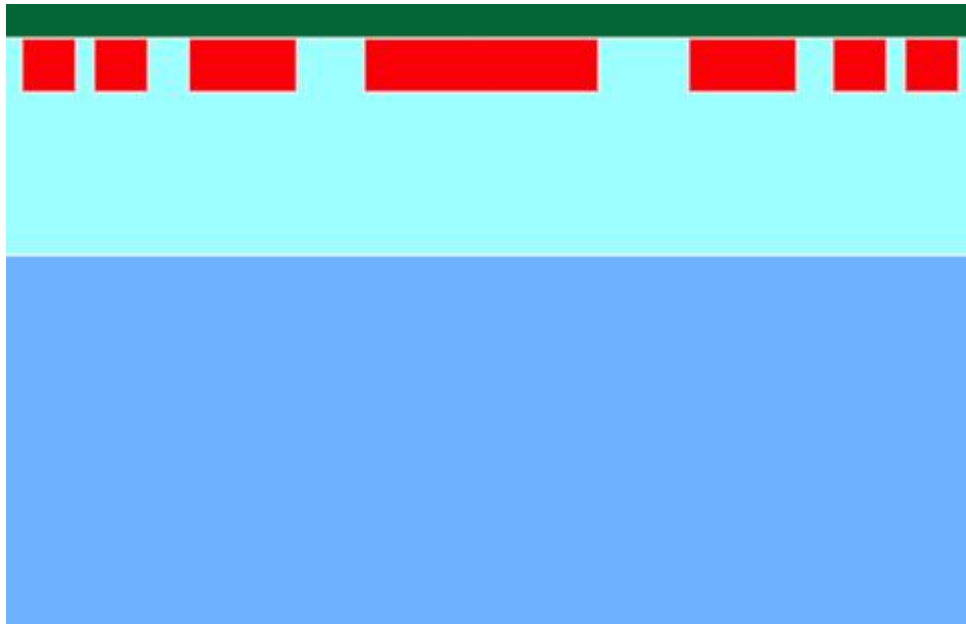
外延晶圆制备（无法使用离子注入，深度太深）



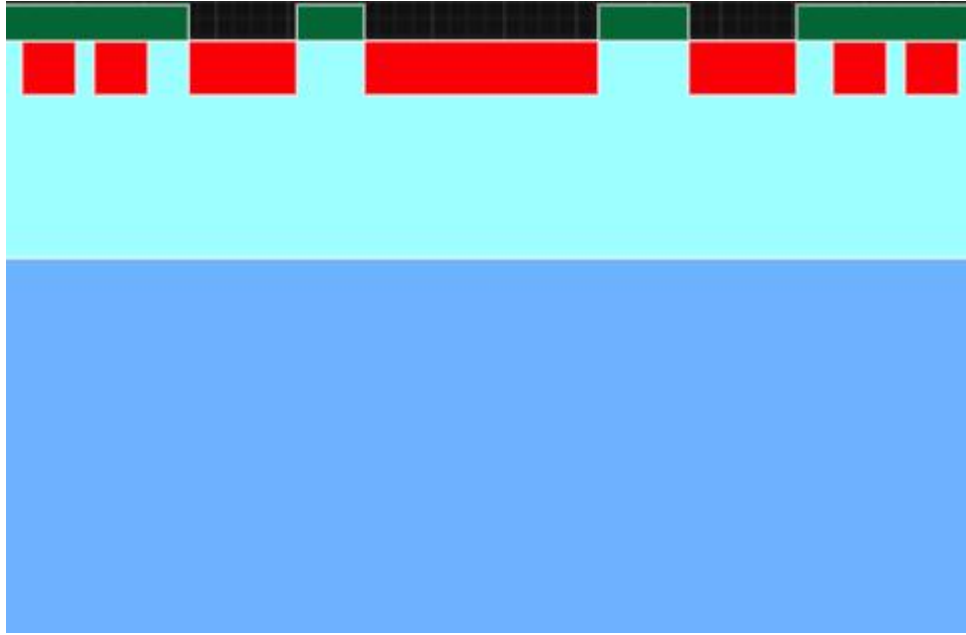
第一次光刻 + P 型离子注入（中心有源区）



第二次光刻 + P 型离子注入 (保护环)



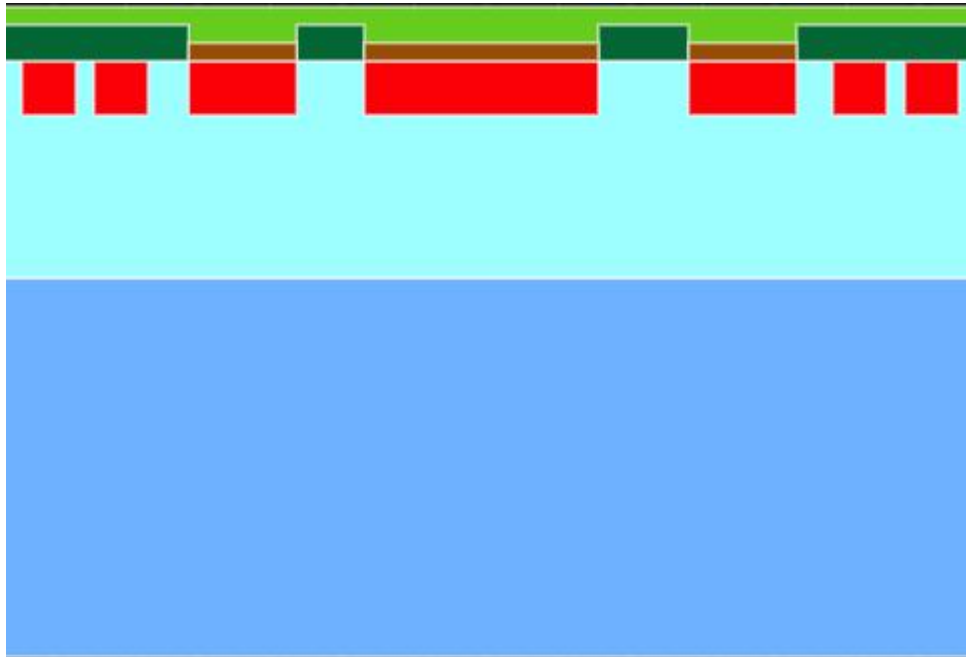
整片沉积隔离 SiO_2 介质



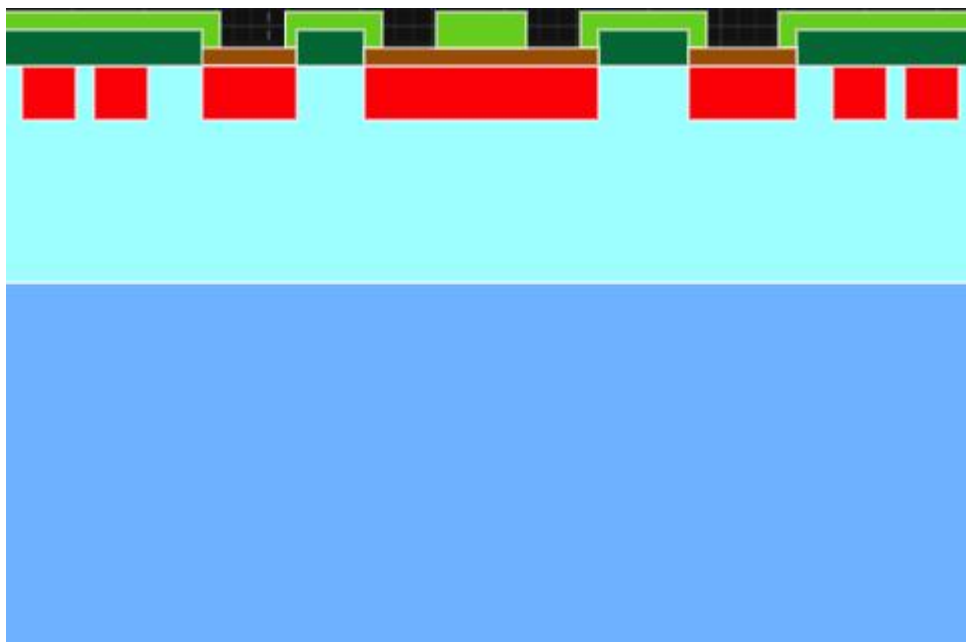
第三次光刻 + 干法刻蚀（接触孔）



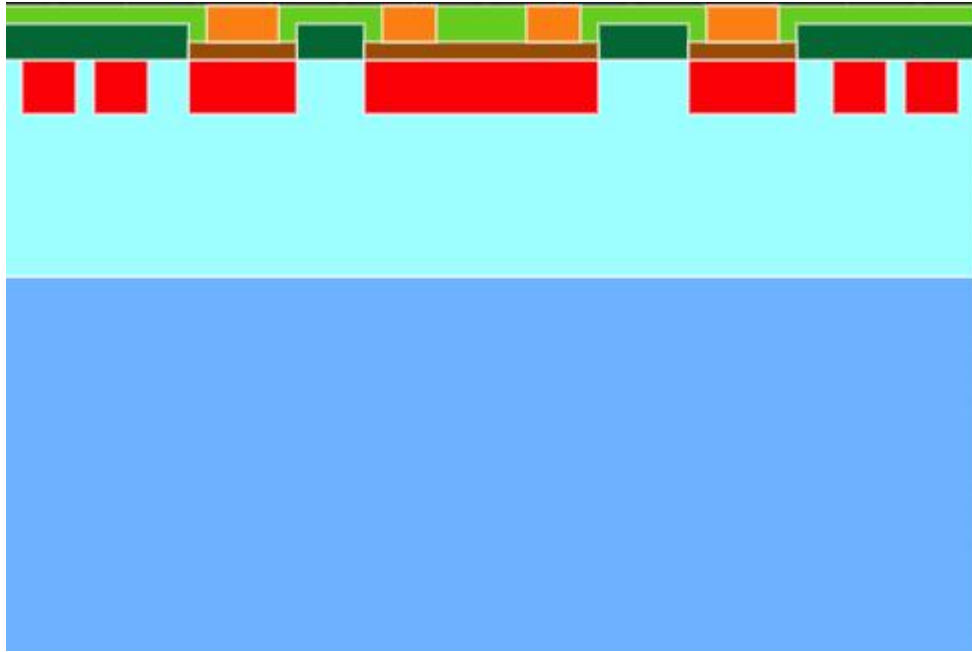
溅射复合金属 + 金属光刻



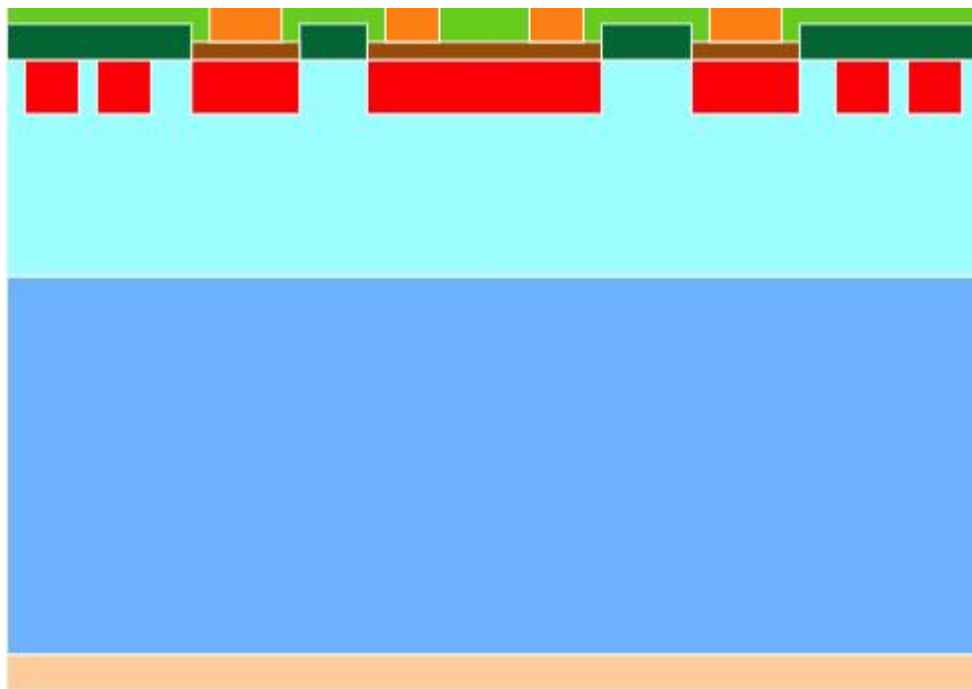
全片沉积钝化保护膜



第四次光刻 + 钝化刻蚀（钝化开窗）

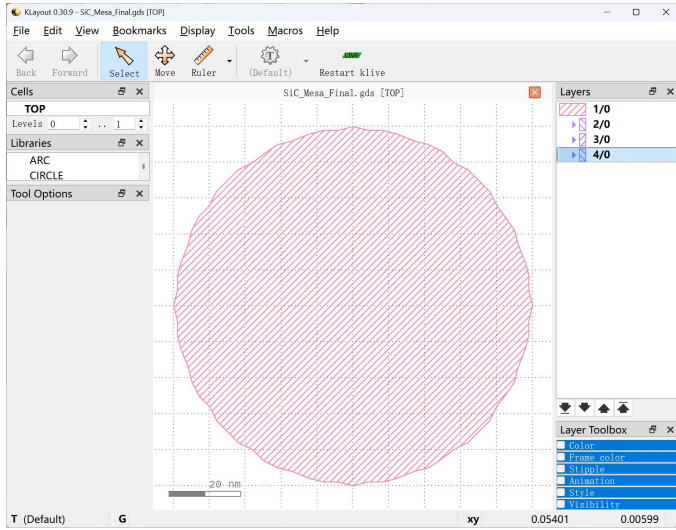


第五次光刻 + 蒸镀 Au (L6 顶层金)

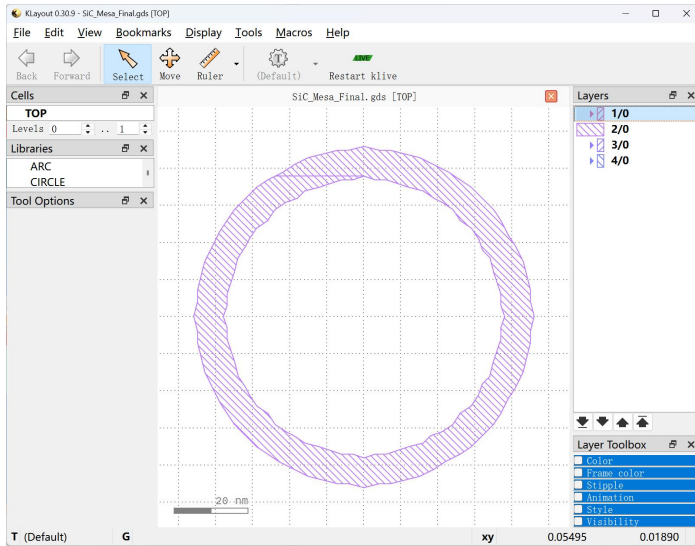


背面工艺 (阴极制备)

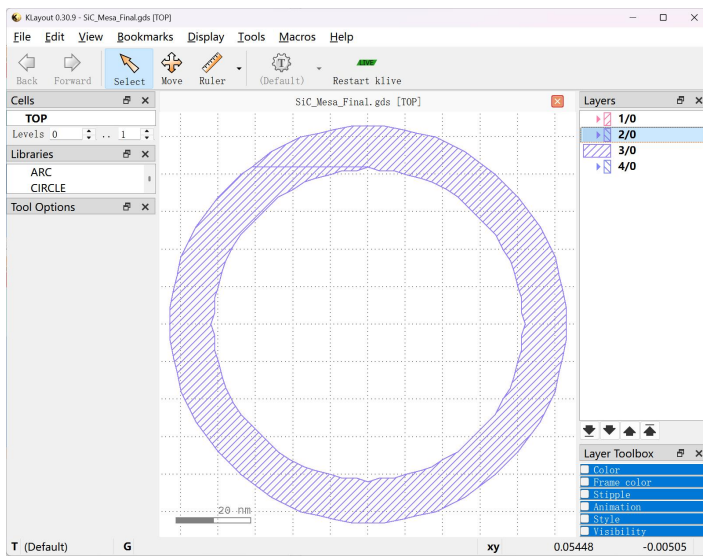
2.刻蚀终端器件光刻板



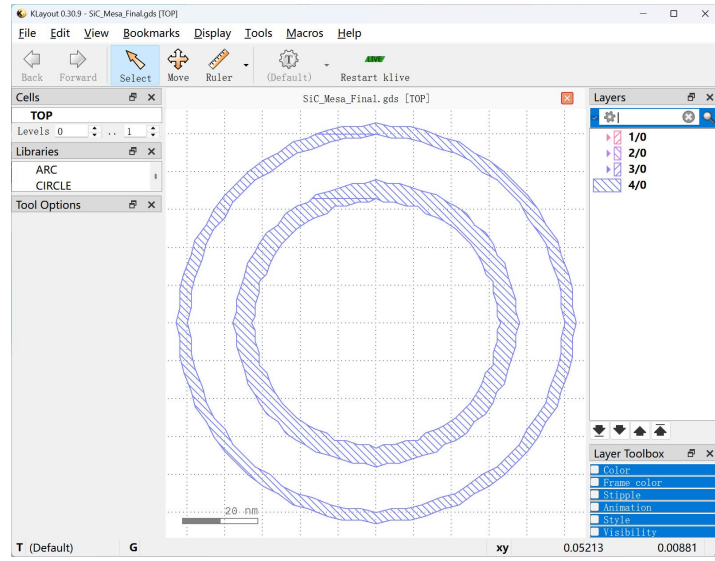
第一层刻蚀终端



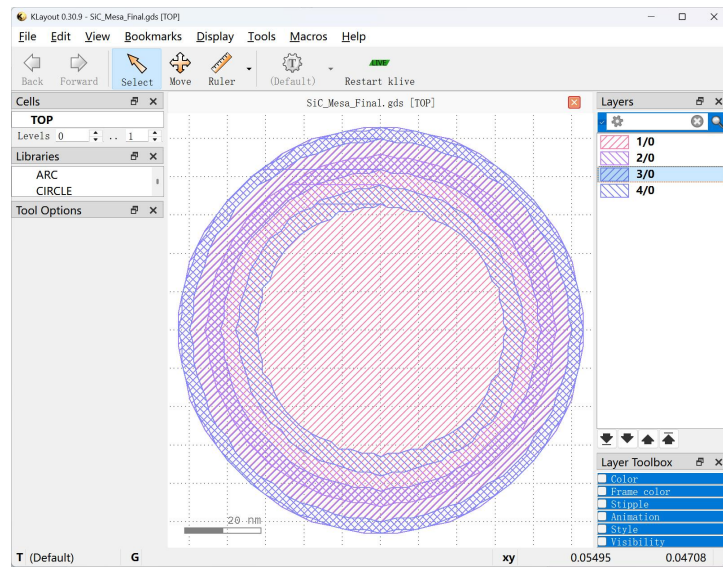
第二层环形接触孔实现欧姆导通



第三层环形 M1 金属



钝化开窗



所有光刻版